

具有太阳能电池最大功率点跟踪功能的 4A 多节电池充电管理集成电路 CN3795

概述:

CN3795 是一款可使用太阳能板供电的 PWM 降压模式多节电池充电管理集成电路，独立对多节电池充电进行管理，具有封装外形小，外围元器件少和使用简单等优点。

CN3795 具有涓流，恒流和恒压充电模式，非常适合锂电池，磷酸铁锂电池和钛酸锂电池充电管理。在恒压充电模式，CN3795 将电池电压调制在外部反馈电阻所设置的电压；在恒流充电模式，充电电流通过一个外部电阻设置。当用太阳能板供电时，内部电路能够自动跟踪太阳能板的最大功率点，用户不需要考虑最坏情况，可最大限度地利用太阳能板的输出功率，非常适合利用太阳能板供电的应用。

对于深度放电的锂电池，当电池电压低于恒压充电电压的66.5%(典型值)时，CN3795用所设置的恒流充电电流的17.5%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段，充电电流逐渐减小，当充电电流降低到恒流充电电流的16%时，充电结束。在充电结束状态，如果充电电流再上升到恒流充电电流的58.8%以上，自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时，CN3795自动进入睡眠模式。

其它功能包括输入低电压锁存，电池端过压保护和充电状态指示等。

CN3795 采用 10 管脚 SSOP 封装。

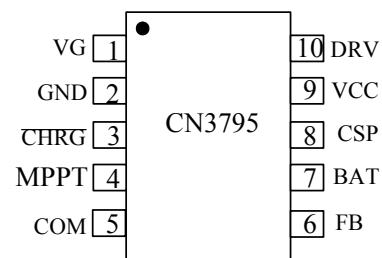
应用:

- 手持设备
- 应急灯
- 备用电池应用
- 便携式工业和医疗仪器
- 电动工具
- 锂电池，磷酸铁锂电池和钛酸锂电池充电

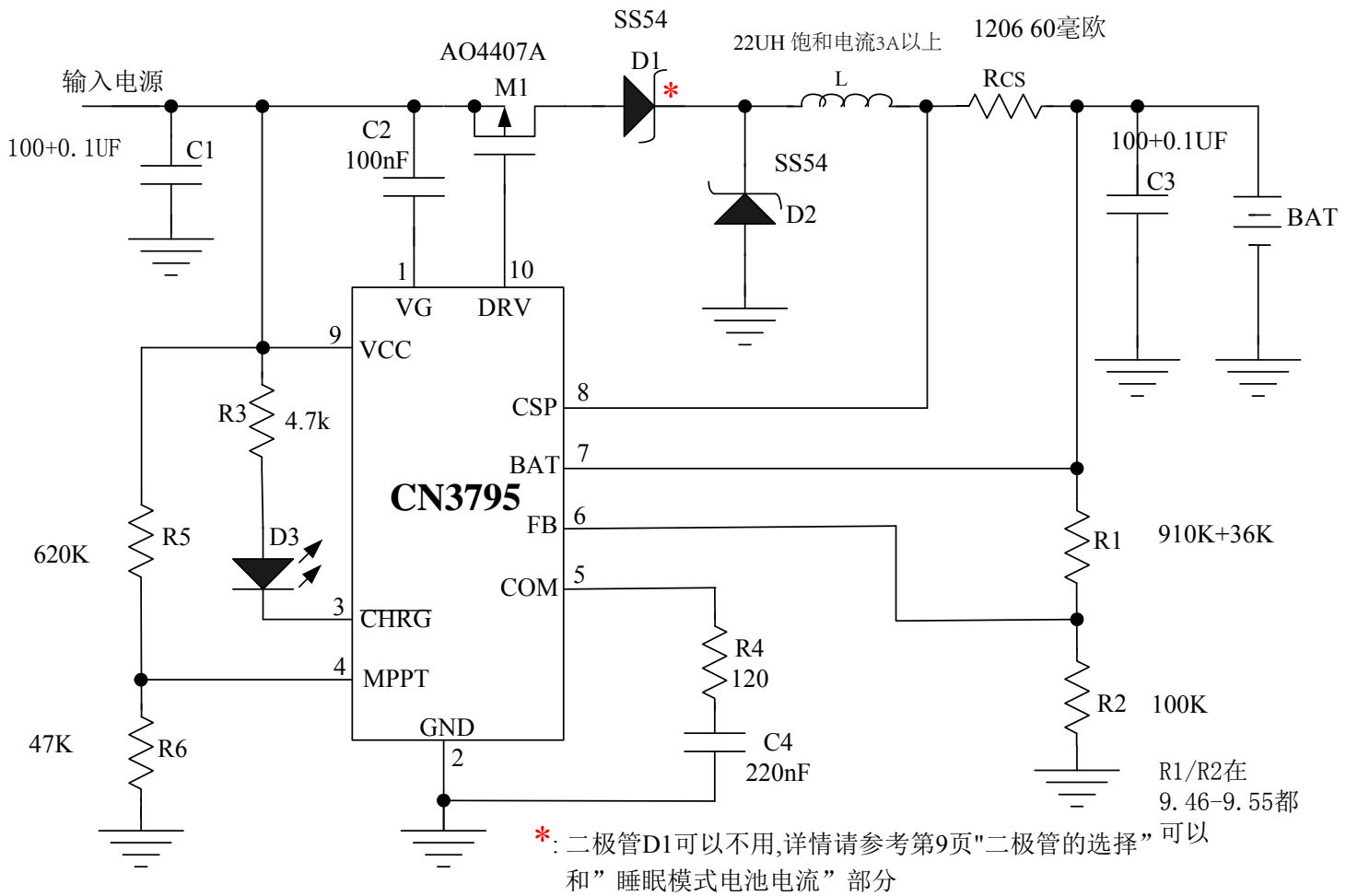
特点:

- 太阳能板最大功率点跟踪功能
- 可对单节或多节锂电池，磷酸铁锂电池或钛酸锂电池进行完整的充电管理
- 宽输入电压范围：6.6V 到 30V
- 电池没有连接时，可作为恒压源使用
- 充电电流可达 4A
- PWM 开关频率：300KHz
- 恒压充电电压由外部电阻设置
- 恒流充电电流由外部电阻设置
- 对深度放电的电池进行涓流充电
- 自动再充电功能
- 充电状态指示
- 软启动功能
- 电池端过压保护
- 工作环境温度：-40℃ 到 +85℃
- 采用 10 管脚 SSOP 封装
- 产品无铅，满足 Rohs，不含卤素

管脚排列:



典型应用电路:



2 A 充电电路

图 1 典型应用电路

订购信息:

| 型号 | 包装 | 工作环境温度 |
|--------|---------------|---------------|
| CN3795 | 盘装, 每盘 4000 只 | -40°C 到 +85°C |

管脚描述:

| 管脚序号 | 名称 | 说明 |
|------|------|---|
| 1 | VG | 内部电压调制器输出。为内部驱动电路提供电源，在 VG 管脚和 VCC 管脚之间需要接一个 100nF 的电容。 |
| 2 | GND | 地。输入电源的负输入端和电池负极。 |
| 3 | CHRG | 充电状态指示端。漏极开路输出。在充电状态，内部晶体管将此管脚拉到低电平；否则，此管脚为高阻状态。 |
| 4 | MPPT | 太阳能板最大功率点跟踪端。在太阳能板最大功率点跟踪状态，此管脚电压被调制到 1.205V。此管脚需要外接电阻分压网络以检测太阳能板的电压。 |
| 5 | COM | 回路补偿输入端。在此管脚到地之间串联连接一个 120Ω 的电阻和一个 220nF 的电容。 |
| 6 | FB | 电池电压反馈输入端。外接电阻分压网络以检测电池电压。 |
| 7 | BAT | 电池正极连接端和充电电流检测负输入端。此管脚连接到电池的正极。同时，此管脚和 CSP 管脚用于测量电流检测电阻 RCS 两端的电压，并将此电压信号反馈给 CN3795 进行电流调制。 |
| 8 | CSP | 充电电流检测正输入端。此管脚和 BAT 管脚用于测量电流检测电阻 RCS 两端的电压，并将此电压信号反馈给 CN3795 进行电流调制。 |
| 9 | VCC | 外部电源正极输入端。VCC 也是内部电路的电源。此管脚到地之间需要接滤波电容。 |
| 10 | DRV | 栅极驱动端。驱动片外 P 沟道 MOS 场效应晶体管的栅极。 |

极限参数

| | |
|------------------------------|-----------------|
| VCC, CHRG 到 GND 的电压..... | -0.3V to 33V |
| VG, DRV 管脚到 VCC 管脚电压..... | -8V to VCC+0.3V |
| CSP, BAT 到 GND 的电压..... | -0.3V to 27V |
| MPPT, COM, FB 到 GND 的电压..... | -0.3V to 6.5V |
| 存储温度..... | -65°C 到 150°C |
| 工作环境温度..... | -40°C 到 85°C |
| 焊接温度(10 秒)..... | 260°C |

超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围，在这样的极限条件下工作，器件的技术指标将得不到保证，长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。

电气特性:

(VCC=15V, TA=-40°C 到 85°C, 除非另有注明)

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |
|---|-------------------|---|----------------------|-------|------|-------------------|----|
| 输入电压范围 | VCC | | 6.6 | | 30 | 伏特 | |
| 低电压锁存阈值 | UVLO | | 4 | 5.2 | 6.5 | 伏特 | |
| 芯片工作电流 | I _{VCC} | V _{BAT} >V _{REG} | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 毫安 | |
| FB 管脚反馈电压 | V _{REG} | 恒压充电模式 | 1.193 | 1.205 | 1.22 | 伏特 | |
| FB 管脚偏置电流 | I _{FB} | V _{FB} =1.2V | | 60 | 300 | 纳安 | |
| 电流检测 | V _{CS} | V _{BAT} >V _{PRE} , V _{CSP} -V _{BAT} | 110 | 120 | 130 | 毫伏 | |
| | | V _{BAT} <V _{PRE} , V _{CSP} -V _{BAT} | 10 | 21 | 36 | | |
| 流入 BAT 管脚电流 | I _{BAT1} | 充电结束模式, V _{BAT} =7.4V | | 10 | 15 | 微安 | |
| | I _{BAT2} | 睡眠模式, V _{BAT} =7.4V | | | 15 | | |
| 涓流充电阈值 | V _{PRE} | BAT管脚电压上升 | 64 | 66.5 | 69 | %V _{REG} | |
| 涓流充电阈值迟滞 | H _{PRE} | BAT管脚电压下降 | | 2.5 | | %V _{REG} | |
| 充电结束阈值 | I _{term} | 充电电流下降 | | 16 | | %I _{CC} | |
| 再充电阈值 | V _{RE} | 充电电流上升 | | 58.8 | | %I _{CC} | |
| 过压阈值 | V _{ov} | BAT 管脚电压上升 | 1.04 | 1.07 | 1.1 | V _{REG} | |
| 过压释放阈值 | V _{clr} | BAT 管脚电压下降 | 1.0 | 1.02 | 1.04 | | |
| CHRG 管脚 | | | | | | | |
| CHRG管脚下拉电流 | I _{CHRG} | V _{CHRG} =1V, 充电状态 | 7 | 12 | 18 | 毫安 | |
| CHRG管脚漏电流 | I _{LK1} | V _{CHRG} =30V, 充电结束状态 | | | 1 | 微安 | |
| MPPT 管脚 | | | | | | | |
| MPPT 管脚调制电压 | V _{MPPT} | 在最大功率点跟踪状态 | 1.18 | 1.205 | 1.23 | V | |
| MPPT 管脚电流 | I _{MPPT} | | -100 | 0 | 100 | nA | |
| 振荡器 | | | | | | | |
| 频率 | f _{osc} | | 240 | 300 | 360 | KHZ | |
| 最大占空比 | D _{max} | | | 94 | | % | |
| 睡眠模式 | | | | | | | |
| 睡眠模式阈值 (测量VCC-V _{BAT}) | V _{SLP} | VCC falling | V _{BAT} =8V | 0.0 | 0.05 | 0.1 | 伏特 |
| 睡眠模式释放阈值 (测量VCC-V _{BAT}) | V _{SLPR} | VCC rising, | V _{BAT} =8V | 0.2 | 0.32 | 0.46 | 伏特 |
| DRV 管脚 | | | | | | | |
| V _{DRV} 高电平 (VCC-V _{DRV}) | VH | I _{DRV} =-10mA | | 60 | | 毫伏 | |
| V _{DRV} 低电平 (VCC-V _{DRV}) | VL | I _{DRV} =0mA | | 6.3 | | 伏特 | |
| 上升时间 | t _r | Load=2nF, 10% to 90% | 30 | 40 | 65 | 纳秒 | |
| 下降时间 | t _f | Load=2nF, 90% to 10% | 30 | 40 | 65 | 纳秒 | |

注: V_{REG} 表示恒压充电电压; I_{CC} 表示恒流充电电流。

详细描述:

CN3795是一款可使用太阳能板供电的PWM降压型多节电池充电管理集成电路，可用于单节或多节锂电池，磷酸铁锂电池或钛酸锂电池的充电管理。CN3795具有涪流，恒流和恒压充电模式。恒流充电电流由CSP管脚和BAT管脚之间的电流检测电阻 R_{CS} 设置。恒压充电电压通过连接于FB管脚的反馈电阻设置。

当VCC管脚电压大于低压锁存阈值，并且大于电池电压时，CN3795正常工作。如果电池电压低于涪流充电阈值，充电器自动进入涪流充电模式，此时充电电流为所设置的恒流充电电流的17.5%。当电池电压大于涪流充电阈值，充电器进入恒流充电模式，此时充电电流由内部的120mV基准电压和一个外部电阻 R_{CS} 设置，即充电电流为 $120\text{mV}/R_{CS}$ 。当电池电压继续上升接近恒压充电电压时，充电器进入恒压充电模式，充电电流逐渐减小。在充电状态，漏极开路输出 $\overline{\text{CHRG}}$ 管脚内部的晶体管导通，输出低电平，以指示充电状态。当充电电流减小到恒流充电电流的16%时，充电结束，DRV管脚输出高电平。漏极开路输出 $\overline{\text{CHRG}}$ 管脚内部的晶体管关断，输出为高阻态，以指示充电结束状态。

在充电结束状态，如果断开输入电源，再重新接入，将开始一个新的充电周期；如果充电电流再上升到再充电阈值以上，那么也将自动开始新的充电周期。

CN3795可以使用太阳能板供电，具有太阳能板最大功率点跟踪功能。太阳能板最大功率点电压通过两个电阻分压后反馈到MPPT管脚，在最大功率点跟踪状态，MPPT管脚电压被调制在1.205V(典型值)。

当输入电压掉电时，CN3795自动进入睡眠模式，内部电路被关断。

CN3795内部还有一个过压比较器，当BAT管脚电压由于负载变化或者突然移走电池等原因而上升时，如果BAT管脚电压上升到恒压充电电压的1.07倍时，过压比较器动作，关断片外的P沟道MOS场效应晶体管，充电器暂时停止，直到BAT管脚电压回复到恒压充电电压的1.02倍以下。在某些情况下，比如在电池没有连接到充电器上，或者电池突然断开，BAT管脚的电压可能会达到过压保护阈值，此为正常现象。

充电电流和充电电压示意图如图2所示。

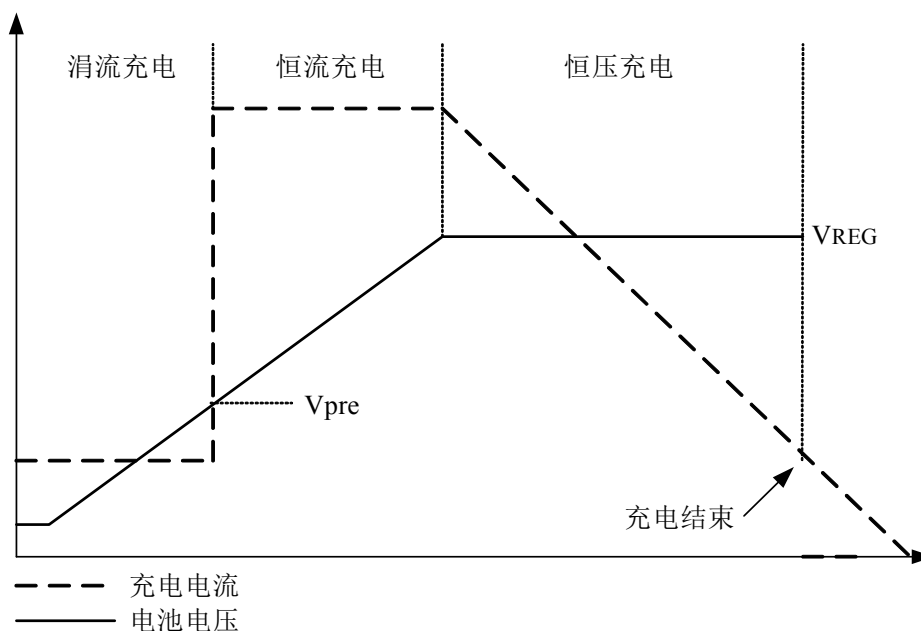


图2 充电过程示意图

应用信息

低电压锁存 (UVLO)

芯片内部的低电压锁存电路监测输入电压，当输入电压低于6.5V(最大值)时，内部电路被关断，CN3795被禁止工作。

涓流充电

在充电状态，如果电池电压低于恒压充电电压的66.5%(典型值)时，充电器进入涓流充电模式，此时充电电流为恒流充电电流的17.5%。

恒流充电电流的设置

恒流充电电流由下式决定：

$$I_{CH} = \frac{120mV}{R_{CS}}$$

其中：

I_{CH} 是恒流充电电流

R_{CS} 是连接于CSP管脚和BAT管脚之间的电流检测电阻

设置恒压充电电压

如图1所示，电池端的电压通过电阻R1和R2构成的电阻分压网络反馈到FB管脚，CN3795根据FB管脚的电压决定充电状态。当FB管脚的电压接近1.205V时，充电器进入恒压充电状态。在恒压充电状态，充电电流逐渐下降，电池电压保持不变。

考虑到流入FB管脚的偏置电流，在恒压充电状态电池端对应的的电压为：

$$V_{BAT} = 1.205 \times (1 + R1 / R2) + I_B \times R1$$

其中， I_B 是FB管脚的偏置电流，其典型值为60nA。

从上式可以看到，FB管脚偏置电流导致电阻分压网络的分压结果存在误差，误差值为 $I_B \times R1$ 。假设 $R1 = 500K\Omega$ ，那么误差值约为30毫伏。所以在设计电阻分压网络时，应该将上述误差考虑在内。

可设置的恒压充电电压不能大于25V。

由于电阻R1和R2会从电池消耗一定的电流，在选取R1和R2的电阻值时，应首先根据所允许消耗的电流选取 $R1 + R2$ 的值，然后再根据上式分别计算R1和R2的值。

太阳能电池最大功率点跟踪

CN3795采用恒电压法跟踪太阳能板的最大功率点。在太阳能板的伏安特性曲线中，当环境温度一定时，在不同的日照强度下，输出最大功率的点所对应的输出电压基本相同，亦即只要保持太阳能板的输出端电压为恒定电压，就可以保证在该温度下光照强度不同时，太阳能板输出最大功率。

CN3795太阳能板最大功率点跟踪端MPPT管脚的电压被调制在1.205V，配合片外的两个电阻(图1中的R5和R6)构成的分压网络，可以实现对太阳能板最大功率点进行跟踪。

太阳能板最大功率点电压由下式决定：

$$V_{MPPT} = 1.205 \times (1 + R5 / R6)$$

充电结束

在恒压充电模式，充电电流逐渐下降，当充电电流下降到恒流充电电流的16%时，充电过程结束， \overline{CHRG} 管脚输出高阻态，指示充电结束。此时CN3795继续以恒压方式对电池充电，以保证电池充满。

当电池电压低于恒压充电电压的95.8%时，即使充电电流下降到恒流充电电流的16%，充电过程也不结束。也就是说，充电结束有两个条件，一个是电池电压大于恒压充电电压的95.8%；另一个条件是充电电流下降到恒流充电电流的16%。

自动再充电

充电结束以后，如果输入电源和电池仍然连接在充电器上，由于电池自放电或者负载的原因，导致充电电流上升到恒流充电电流的58.8%以上时，CN3795自动进入充电状态，开始新的充电周期。

状态指示

CN3795有一个漏极开路状态指示输出端： $\overline{\text{CHRG}}$ 管脚。在充电状态， $\overline{\text{CHRG}}$ 管脚被内部晶体管下拉到低电平，在其它状态 $\overline{\text{CHRG}}$ 管脚为高阻态。

当电池没有接到充电器时，CN3795可作为电压源输出恒定电压，电压值为所设置的恒压充电电压，此时 $\overline{\text{CHRG}}$ 管脚为高阻态。

当不用状态指示功能时，将 $\overline{\text{CHRG}}$ 管脚接到地。

表1列明了 $\overline{\text{CHRG}}$ 管脚对应的充电器状态。这里假设红色LED连接到 $\overline{\text{CHRG}}$ 管脚，其连接方式如图1所示。

| $\overline{\text{CHRG}}$ 管脚 | 状态描述 |
|-----------------------------|--|
| 低电平(红色LED亮) | 充电 |
| 高阻态(红色LED灭) | 三种可能情况 <ul style="list-style-type: none"> ● VCC管脚电压低于低压锁存电压，或者 ● VCC管脚电压低于BAT管脚电压，或者 ● 充电结束 |

表1 状态指示说明

片外功率管驱动

CN3795的DRV管脚用于驱动片外MOS场效应晶体管的栅极，该管脚能够提供比较大的瞬态电流以快速开启和关断片外MOS场效应晶体管。在驱动2nF的负载情况下，上升时间和下降时间典型值为30nS。一般来讲，一个导通电阻为35毫欧，30V的MOS场效应晶体管的等效电容大约为2nF。

CN3795内部有钳位电路，以保证DRV管脚的低电平比VCC管脚的电压低8V(最大值)。比如，假设VCC的电压为20V，那么DRV管脚的低电平为最小12V。这样，一些具有极低导通电阻的低压P沟道MOS场效应晶体管可以与CN3795配合使用，从而提高了充电器的工作效率，客户也有更多的选择。

回路补偿

为了保证电流调制回路和电压调制回路的稳定性，需要从COM到地之间串联连接一个120Ω的电阻和一个220nF的瓷片电容。

CN3795作为恒压源使用

当电池没有连接到充电器上时，CN3795可作为恒压源使用，其输出电压值为所设置的恒压充电电压，最大输出电流为所设置的恒流充电电流。

输入电容

输入电容(图1中的C1)对输入电源起滤波作用，需要吸收在输入电源上产生的纹波电流，所以输入电容必须有足够的额定纹波电流。在最坏情况下，输入电容的额定RMS纹波电流需要达到充电电流的二分之一。同时为了抑制寄生电感等在开关瞬间产生的高频振荡，输入电容最好由下面三个电容并联组成：

- 电解电容：电容值由输入电源的特性和充电电流等因素决定
- 陶瓷电容：电容值在1uF到10uF
- 高频陶瓷电容：电容值在47nF到1uF

输出电容

为了降低输出端的纹波电压和改善瞬态特性，输出电容(图1中的C3)应该选择串联等效电阻(ESR)较小的电容。输出电容最好由下面两个电容并联组成：

- 电解电容：电容值10uF
- 陶瓷电容：电容值在1uF到10uF

如果输出电容只能使用陶瓷电容，须留意有些陶瓷电容的电压系数比较大，有效电容值变低，在电池没有连接时BAT管脚电压可能过高，在这种情况下，应该适当增大输出电容值或用几个小容值的陶瓷电容并联，

以

保证在电池没有连接时，BAT管脚电压在安全范围内。

电感的选择

在正常工作时，电感瞬态电流是周期性变化的。在P沟道MOS场效应晶体管导通期间，输入电压对电感充电，电感电流增加；在P沟道MOS场效应晶体管关断期间，电感向电池放电，电感电流减小。电感的纹波电流随着电感值的减小而增大，随着输入电压的增大而增大。较大的电感纹波电流会导致较大的纹波充电电流和磁损耗。所以电感的纹波电流应该被限制在一个合理的范围内。

电感的纹波电流可由下式估算：

$$\Delta I_L = \frac{1}{f(L)} V_{BAT} \left(1 - \frac{V_{BAT}}{V_{CC}}\right)$$

其中：

f是开关频率，300KHz

L是电感值

V_{BAT} 电池电压

VCC是输入电压

在选取电感值时，可将电感纹波电流限制在 $\Delta I_L \leq 0.3 \times I_{CH}$ ， I_{CH} 是充电电流。请留意最大电感纹波电流 ΔI_L 出现在输入电压最大值和电感最小值的情况下。

除了上述的公式，电感值应该同时满足下面公式要求：

$$L > 5 \times (V_{CC} - V_{BAT}) \quad (\mu H)$$

为保证有较低的电磁辐射，电感最好为贴片式屏蔽电感。

MOSFET的选择

CN3795的应用电路需要使用一个P沟道MOS场效应晶体管。选择该MOS场效应晶体管时应综合考虑转换效率，MOS场效应晶体管功耗以及最高温度。

在芯片内部，栅极驱动电压被钳位在6.3V(典型值)，可以使用低开启电压的P沟道MOS场效应晶体管。所以需要留意该MOS场效应晶体管的击穿电压 BV_{DSS} 要大于最高输入电压。

选择P沟道MOS场效应晶体管时需要考虑的因素包括导通电阻 $R_{ds(on)}$ ，栅极总电荷 Q_g ，反向传导电容 C_{RSS} ，输入电压和最大充电电流。

MOS场效应晶体管的最大功率可以用下式来近似：

$$P_d = \frac{V_{BAT}}{V_{CC}} \times R_{ds(on)} \times I_{CH}^2 \times (1 + 0.005 dT)$$

其中：

P_d 是MOS场效应晶体管的功耗

V_{BAT} 是电池的最高电压

VCC是最小输入电压

$R_{ds(on)}$ 是P沟道场效应晶体管在室温(25°C)条件下的导通电阻

I_{CH} 是充电电流

dT是P沟道MOS场效应晶体管的实际温度与室温(25°C)的温度差

除了前面公式所描述的导通损耗 $I^2 R_{ds(on)}$ 外，MOS场效应晶体管还有开关损耗，开关损耗随着输入电压的增加而增加。一般来讲，在输入电压小于20V时，导通损耗大于开关损耗，应该优先考虑导通电阻比较小的MOS场效应晶体管；在输入电压大于20V时，开关损耗大于导通损耗，应该优先考虑反向传导电容 C_{RSS} 比较小的MOS场效应晶体管。一般 C_{RSS} 的值在MOS场效应晶体管的技术规格书中都有列明，如果没有明确列明该电容值，可由公式 $C_{RSS} = Q_{GD} / \Delta V_{DS}$ 来估算。

很多型号的MOS场效应晶体管，比如CN2305，4435，4459，9435(或9435)和3407A，都可以选用。前面所列MOS场效应晶体管的型号仅供参考，用户需要根据具体要求来选用适合的型号。

二极管的选择

在典型应用电路图1中的二极管D1和D2均为肖特基二极管。这两个二极管通过电流能力至少要比充电电流大；二极管的耐压要大于最高输入电压的要求。

二极管D1和D2的选择原则为够用即可，如果所选用二极管的通过电流能力或耐压远远超过所需要的值，由于这样的二极管具有较高的结电容，将增加充电器的开关损耗，降低效率。

二极管D1用来作阻流二极管，防止在输入电源掉电时消耗电池的能量。在睡眠模式，如不用二极管D1，CN3795消耗的电池电流大约51微安，所以可根据电池容量等因素考虑不用二极管D1。

睡眠模式电池电流

在图1所示的典型应用电路中，当输入电压掉电或者输入电压低于电池电压时，CN3795进入睡眠模式。在睡眠模式电池消耗的电流包括：

- (1) 流入BAT管脚和CSP管脚的电流，大约为10uA($V_{BAT}=8V$)
- (2) 从电池端经过阻流二极管D1流到输入电压端的电流，此电流由二极管D1的漏电流决定；
如果不用二极管D1，电池电压通过电感，MOS场效应晶体管的体二极管施加到CN3795的VCC管脚，流入VCC管脚电流大约42uA($V_{BAT}=8V$)。
- (3) 从电池端经过二极管D2流到地(GND)的电流，此电流由二极管D2的漏电流决定。

关于高频振荡的抑制

在高输入电压或大充电电流的情况下，如果PCB布局布线不合理，或者二极管，P沟道场效应晶体管的寄生电感比较大，在P沟道场效应晶体管导通或关断瞬间，会产生几十兆赫兹以上的高频振荡，用示波器可以在输入电源的正极和二极管D2的负极观测到高频振荡波形。

为了抑制高频辐射，除了改进PCB布局布线以外，还可以增加高频抑制电路，如图3中的R5和C5。

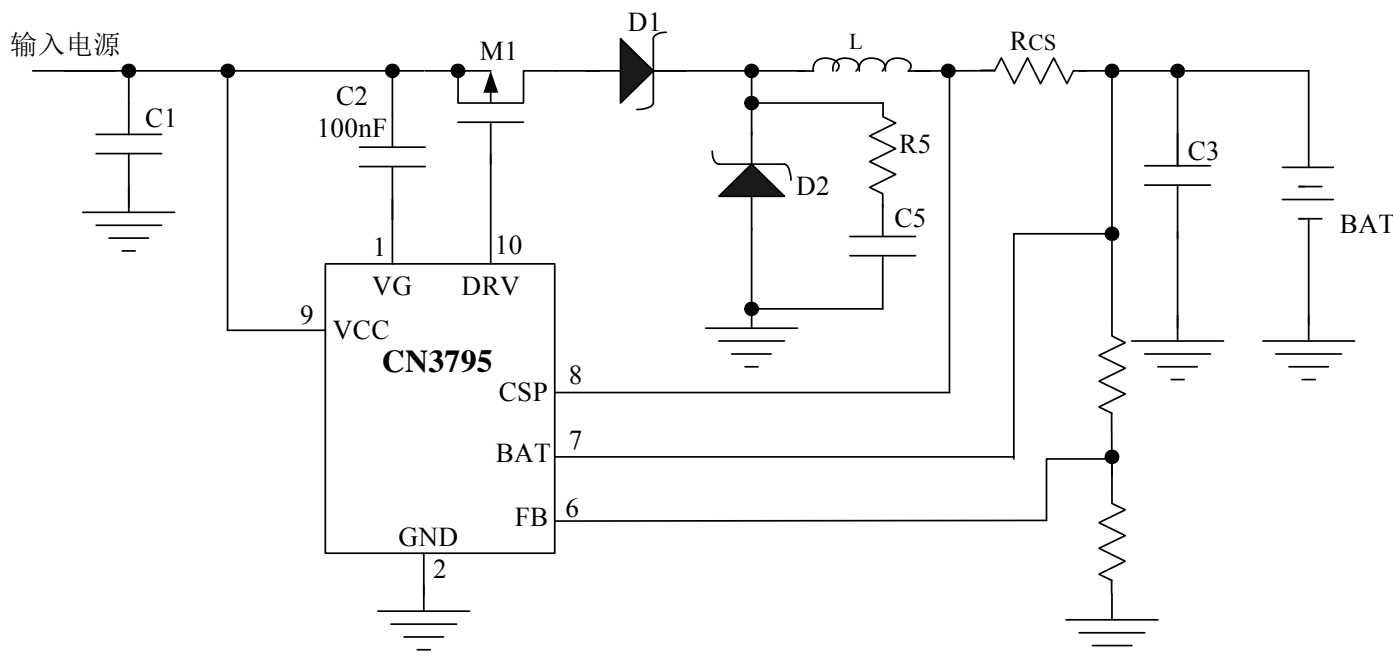


图3 高频振荡抑制

设计PCB的考虑

良好的PCB设计对于保证CN3795正常工作，降低电磁辐射和提高转换效率非常重要。针对图1中的电路，设计PCB时需要考虑下面几点：

- (1) 输入滤波电容正极要靠近P沟道MOS场效应晶体管的源极；
- (2) 二极管D1和D2须靠近电感，电流检测电阻须靠近电感；
- (3) 输出电容须靠近电流检测电阻；
- (4) 输入滤波电容，P沟道MOS场效应晶体管，二极管D1和D2，电感，电流检测电阻和输出滤波电容的引线要尽量短；
- (5) 电阻R1，R2，R4，R5，R6和电容C4要尽量靠近CN3795；
- (6) 在CN3795的GND管脚，电阻R2，R6接地端和COM管脚的回路补偿元件的接地端要单独接到系统地，这样可以避免开关噪声影响回路的稳定性。输入电容的接地端，二极管D2的正极和输出电容的接地端要先接到同一块铜皮再返回系统地。此点对保证CN3795正常工作非常重要。
- (7) 电流检测电阻 R_{CS} 的放置方向要保证从芯片的CSP管脚和BAT管脚到 R_{CS} 的连线比较短。CSP管脚和BAT管脚的连线要在同一层次上，而且距离要尽可能小。为了保证充电电流检测精度，CSP管脚和BAT管脚要直接连接到电流检测电阻上。如图4所示。

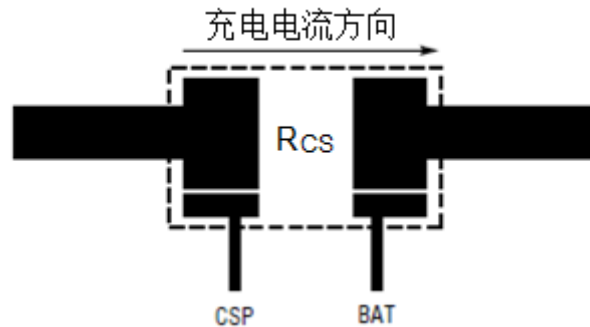
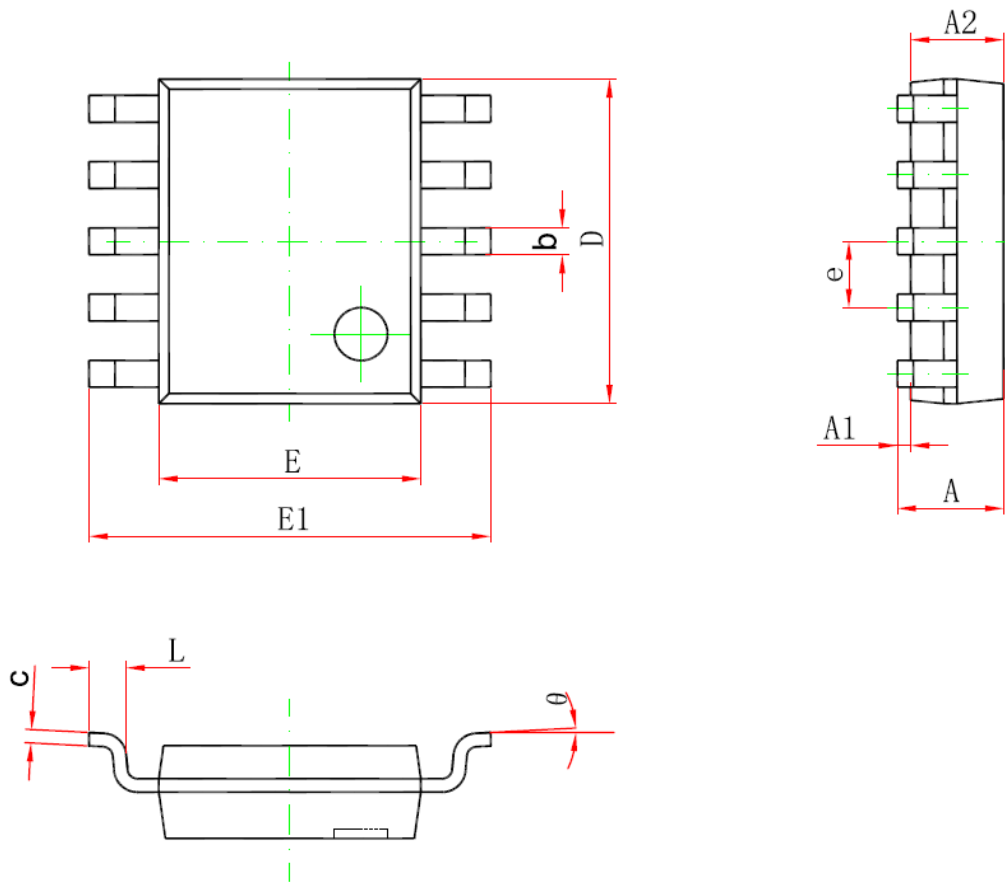


图 4 充电电流的检测

封装信息



| Symbol | Dimensions In Millimeters | | Dimensions In Inches | |
|----------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| | Min | Max | Min | Max |
| A | 1.350 | 1.750 | 0.053 | 0.069 |
| A1 | 0.100 | 0.250 | 0.004 | 0.010 |
| A2 | 1.350 | 1.550 | 0.053 | 0.061 |
| b | 0.300 | 0.450 | 0.012 | 0.018 |
| c | 0.170 | 0.250 | 0.007 | 0.010 |
| D | 4.700 | 5.100 | 0.185 | 0.201 |
| E | 3.800 | 4.000 | 0.150 | 0.157 |
| E1 | 5.800 | 6.200 | 0.228 | 0.244 |
| e | 1.000 (BSC) | | 0.039 (BSC) | |
| L | 0.400 | 1.270 | 0.016 | 0.050 |
| θ | 0° | 8° | 1° | 8° |